

Содержание

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Бессолов В.Н., Коненкова Е.В., Родин С.Н.

Начальные стадии роста слоя GaN(11 $\bar{2}$ 2) на наноструктурированной подложке Si(113) 3

Басалаев Ю.М., Дугинова Е.Б., Басалаева О.Г.

Первопринципное исследование электронных, колебательных и упругих свойств кристаллов LiInTe₂ и LiTlTe₂ 7

● Электронные свойства полупроводников

Борздов В.М., Борздов А.В., Василевский Ю.Г.

Разыгрывание полярного угла рассеяния электронов на ионах примеси при моделировании процессов переноса заряда в полупроводниках методом Монте-Карло 14

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Пашковский А.Б., Богданов С.А., Бакаров А.К., Журавлев К.С., Лапин В.Г., Лукашин В.М., Карпов С.Н., Рогачев И.А., Терешкин Е.В.

Всплеск дрейфовой скорости электронов в гетероструктурах с двусторонним донорно-акцепторным легированием и цифровыми барьерами 21

● Углеродные системы

Андронов А.А., Позднякова В.И.

О ТГц лазерах на циклотронном резонансе в графене в скрещенных E, H полях при $T = 300$ К и в непрерывном режиме 29

● Физика полупроводниковых приборов

Сорокина С.В., Солдатенков Ф.Ю., Потапович Н.С., Хвостиков В.П.

Фронтальный контакт к GaSb-фотопреобразователям: свойства и температурная стабильность 35

Закгейм А.Л., Карандашев С.А., Климов А.А., Кунков Р.Э., Лухмырина Т.С., Матвеев Б.А., Ременный М.А., Усикова А.А., Черняков А.Е.

К вопросу о механизмах разогрева светодиодов на основе p -InAsSbP/ n -InAs(Sb) 42

Лебедев А.А., Козловский В.В., Левинштейн М.Е., Малевский Д.А., Оганесян Г.А.

Влияние протонного облучения на свойства высоковольтных интегрированных 4H-SiC диодов Шоттки в рабочем диапазоне температур 53

Токарев А.С., Лапшина О.А., Козырев А.А.

Влияние ионной очистки поверхности излучающего слоя 9xx нм лазерных диодов на основе InGaAs/AlGaAs/GaAs на их предельную мощность излучения 58

Бабичев А.В., Комаров С.Д., Ткач Ю.С., Неведомский В.Н., Блохин С.А., Крыжановская Н.В., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Новиков И.И.

Исследование фотолюминесценции в системе InGaAs/GaAs с квантовыми точками спектрального диапазона 1100 нм 63

Снигирев Л.А., Ушанов В.И., Иванов А.А., Берт Н.А., Кириленко Д.А., Яговкина М.А., Преображенский В.В., Путято М.А., Семягин Б.Р., Касаткин И.А., Чалдышев В.В.

Структура и оптические свойства композитного метаматериала AsSb–Al_{0.6}Ga_{0.4}As_{0.97}Sb_{0.03} 71